

SN54SC1G08-SEP 放射線耐性、単一 2-入力 正論理 AND ゲート

1 特長

- VID TBD-01XE
- 放射線 - トータルドーズ効果 (TID):
 - 50krad(Si) まで吸収線量 (TID) 特性を評価済み
 - 30krad(Si) まで吸収線量 (TID) 性能保証
 - すべてのウェハー ロットについて、30krad(Si) までの放射線ロット受け入れテスト (RLAT)
- 放射線 - シングル イベント効果 (SEE):
 - 単一イベントラッチアップ (SEL) 耐性: 125°C で 50MeV-cm²/mg まで
 - シングル イベント過渡 (SET) 特性: LET = 50MeV-cm²/mg (最大値)
- 幅広い動作範囲: 1.2V ~ 5.5V
- 5.5V 耐圧入力ピン
- 標準ピン配置をサポート
- 5V または 3.3V の V_{CC} で最大 150Mbps
- JESD 78 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- 宇宙用強化プラスチック
 - 防衛および航空宇宙アプリケーションのサポート
 - 管理されたベースライン
 - Au ボンド ワイヤと NiPdAu リード仕上げ
 - NASA ASTM E595 アウトガス仕様に適合
 - 単一の製造、アセンブリ、テスト施設
 - 長期にわたる製品ライフ サイクル
 - 製品のトレーサビリティ

2 アプリケーション

- デジタル信号のイネーブルまたはディスエーブル
- インジケータ LED の制御

3 説明

この SN54SC1G08-SEP デバイスは、プール関数または $Y = A \cdot B$ or $Y = \overline{A} + \overline{B}$ を正論理で実行します。

この CMOS デバイスは出力駆動能力が大きく、広い V_{CC} 動作範囲にわたって静止電力消費が低く保たれます。

パッケージ情報

部品番号	パッケージ ⁽¹⁾	パッケージ サイズ ⁽²⁾	本体サイズ ⁽³⁾
SN54SC1G08-SEP	DBV (SOT-23, 5)	2.9mm × 2.8mm	2.9mm × 1.65mm

- 供給されているすべてのパッケージについては、[セクション 11](#) を参照してください。
- パッケージサイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンを含みます。
- 本体サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、ピンは含まれません。



ロジック図

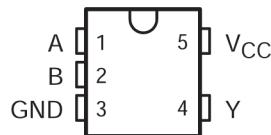


このリソースの元の言語は英語です。翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

目次

1 特長	1	8 アプリケーションと実装	12
2 アプリケーション	1	8.1 アプリケーション情報	12
3 説明	1	8.2 代表的なアプリケーション	12
4 ピン構成および機能	3	8.3 設計要件	13
5 仕様	4	8.4 詳細な設計手順	14
5.1 絶対最大定格	4	8.5 アプリケーション曲線	15
5.2 ESD 定格	4	8.6 電源に関する推奨事項	16
5.3 推奨動作条件	4	8.7 レイアウト	16
5.4 熱に関する情報	5	9 デバイスおよびドキュメントのサポート	18
5.5 電気的特性	6	9.1 ドキュメントのサポート	18
5.6 スイッチング特性	6	9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法	18
5.7 代表的特性	7	9.3 サポート・リソース	18
6 パラメータ測定情報	8	9.4 商標	18
7 詳細説明	9	9.5 静電気放電に関する注意事項	18
7.1 概要	9	9.6 用語集	18
7.2 機能ブロック図	9	10 改訂履歴	18
7.3 機能説明	10	11 メカニカル、パッケージ、および注文情報	19
7.4 デバイスの機能モード	11		

4 ピン構成および機能



寸法については、機械的な図を参照してください。

図 4-1. DBV パッケージ 5 ピン SOT-23 (上面図)

表 4-1. ピンの機能

ピン		種類 ⁽¹⁾	説明
名称	DBV		
A	1	I	データ入力
B	2	I	データ入力
GND	3	-	グランド
Y	4	O	データ出力
V _{cc}	5	-	電源

(1) 信号タイプ:I = 入力、O = 出力、I/O = 入力または出力

5 仕様

5.1 絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) ⁽¹⁾

			最小値	最大値	単位
V_{CC}	電源電圧範囲		-0.5	6.5	V
V_I	入力電圧範囲 ⁽²⁾		-0.5	6.5	V
V_O	出力電圧範囲 ⁽²⁾		-0.5	$V_{CC} + 0.5$	V
I_{IK}	入力クランプ電流	$V_I < 0V$		-50	mA
I_{OK}	出力クランプ電流	$V_O < 0V$		-50	mA
I_O	連続出力電流			± 50	mA
I_O	V_{CC} または GND を通過する連続出力電流			± 100	mA
T_J	接合部温度		-65	150	°C
T_{stg}	保存温度		-65	150	°C

- (1) 「絶対最大定格」の範囲外の動作は、デバイスの永続的な損傷の原因となる可能性があります。「絶対最大定格」は、これらの条件において、または「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを暗に示すものではありません。「絶対最大定格」の範囲内で、一時的に「推奨動作条件」の範囲を超えた動作をさせる場合、必ずしもデバイスが損傷を受けるものではありませんが、完全には機能しない可能性があります。この方法でデバイスを動作させると、デバイスの信頼性、機能性、性能に影響を及ぼし、デバイスの寿命を短縮する可能性があります。
- (2) 入力と出力の電流定格を順守しても、入力と出力の電圧定格を超えることがあります。

5.2 ESD 定格

			値	単位
$V_{(ESD)}$	静電放電	人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 準拠 ⁽¹⁾	± 2000	V
		デバイス帯電モデル (CDM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 準拠 ⁽²⁾	± 1000	

- (1) JEDEC のドキュメント JEP155 に、500V HBM では標準の ESD 管理プロセスで安全な製造が可能であると規定されています。
(2) JEDEC のドキュメント JEP157 に、250V CDM では標準の ESD 管理プロセスで安全な製造が可能であると規定されています。

5.3 推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

仕様	概要	条件	最小値	最大値	単位
V_{CC}	電源電圧		1.1	5.5	V
V_I	入力電圧		0	5.5	V
V_O	出力電圧	(High または Low 状態)	0	V_{CC}	V
I_{OH}	High レベル出力電流	$V_{CC} = 1.65V$	-4		mA
		$V_{CC} = 2.3V$	-8		
		$V_{CC} = 3.0V$	-16		
			-24		
		$V_{CC} = 4.5V$	-32		
I_{OL}	Low レベル出力電流	$V_{CC} = 1.65V$	4		mA
		$V_{CC} = 2.3V$	8		
		$V_{CC} = 3.0V$	16		
			24		
		$V_{CC} = 4.5V$	32		
$\Delta t/\Delta v$	入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレート	$V_{CC} = 1.2V \sim 5.0V$		20	ns/V
$\Delta t/\Delta v$	入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレート	$V_{CC} = 1.8V \pm 0.15V$		20	ns/V

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

仕様	概要	条件	最小値	最大値	単位
$\Delta t/\Delta v$	入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレート	$V_{CC} = 2.5V \pm 0.2V$		20	ns/V
$\Delta t/\Delta v$	入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレート (1G04, 1G06, 1G07, 1G34)	$V_{CC} = 3.3V \pm 0.3V$		10	ns/V
$\Delta t/\Delta v$	入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレート (1G34)	$V_{CC} = 5.0V \pm 0.5V$		10	ns/V
$\Delta t/\Delta v$	入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレート (1G04, 1G06, 1G07)	$V_{CC} = 5.0V \pm 0.5V$		5	ns/V
T_A	自由空気での動作温度		-55	125	°C
V_{IH}	High レベル入力電圧	$V_{CC} = 1.1V$	0.75		V
V_{IH}	High レベル入力電圧	$V_{CC} = 1.32V$	0.78		V
V_{IH}	High レベル入力電圧	$V_{CC} = 1.5V$	0.975		V
V_{IH}	High レベル入力電圧	$V_{CC} = 1.65V$	1.075		V
V_{IH}	High レベル入力電圧	$V_{CC} = 1.95V$	1.2675		V
V_{IH}	High レベル入力電圧	$V_{CC} = 2.3V$	1.7		V
V_{IH}	High レベル入力電圧	$V_{CC} = 2.7V$	1.7		V
V_{IH}	High レベル入力電圧	$V_{CC} = 3.0V$	2		V
V_{IH}	High レベル入力電圧	$V_{CC} = 3.6V$	2		V
V_{IH}	High レベル入力電圧	$V_{CC} = 4.5V$	3.15		V
V_{IH}	High レベル入力電圧	$V_{CC} = 5.5V$	3.85		V
V_{IL}	Low レベル入力電圧	$V_{CC} = 1.1V$		0.3	V
V_{IL}	Low レベル入力電圧	$V_{CC} = 1.32V$		0.42	V
V_{IL}	Low レベル入力電圧	$V_{CC} = 1.5V$		0.525	V
V_{IL}	Low レベル入力電圧	$V_{CC} = 1.65V$		0.5775	V
V_{IL}	Low レベル入力電圧	$V_{CC} = 1.95V$		0.6825	V
V_{IL}	Low レベル入力電圧	$V_{CC} = 2.3V$		0.7	V
V_{IL}	Low レベル入力電圧	$V_{CC} = 2.7V$		0.7	V
V_{IL}	Low レベル入力電圧	$V_{CC} = 3.0V$		0.8	V
V_{IL}	Low レベル入力電圧	$V_{CC} = 3.6V$		0.8	V
V_{IL}	Low レベル入力電圧	$V_{CC} = 4.5V$		1.35	V
V_{IL}	Low レベル入力電圧	$V_{CC} = 5.5V$		1.65	V

5.4 热に関する情報

パッケージ	ピン	熱評価基準 ⁽¹⁾						単位
		$R_{\theta JA}$	$R_{\theta JC(\text{top})}$	$R_{\theta JB}$	Ψ_{JT}	Ψ_{JB}	$R_{\theta JC(\text{bot})}$	
DBV (SOT-23, 5)	5	357.1	263.7	264.4	195.6	262.2	-	°C/W

(1) 従来および最新の熱評価基準の詳細については、『半導体およびICパッケージの熱評価基準』アプリケーションノートを参照してください。

5.5 電気的特性

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ	テスト条件	V _{CC}	-55°C ~ 125°C			単位
			最小値	標準値	最大値	
V _{OH}	I _{OH} = -100µA	1.1V ~ 5.5V	V _{CC} - 0.1			V
V _{OH}	I _{OH} = -4mA	1.65V		1.2		V
V _{OH}	I _{OH} = -8mA	2.3V		1.9		V
V _{OH}	I _{OH} = -12mA	2.7V		2.2		V
V _{OH}	I _{OH} = -16mA	3V		2.4		V
V _{OH}	I _{OH} = -24mA	3V		2.3		V
V _{OH}	I _{OH} = -32mA	4.5V		3.8		V
V _{OL}	I _{OL} = 100µA	1.1V ~ 5.5V		0.15		V
V _{OL}	I _{OL} = 4mA	1.65V		0.45		V
V _{OL}	I _{OL} = 8mA	2.3V		0.3		V
V _{OL}	I _{OL} = 12mA	2.7V		0.4		V
V _{OL}	I _{OL} = 16mA	3V		0.4		V
V _{OL}	I _{OL} = 24mA	3V		0.55		V
V _{OL}	I _{OL} = 32mA	4.5V		0.55		V
I _I	V _I = V _{CC} または GND	V _{CC} = 0V ~ 5.5V		±1	±5	µA
I _{off}	V _I または V _O = V _{CC}	V _{CC} = 0V		±1	±10	µA
I _{CC}	V _I = V _{CC} または GND, I _O = 0	V _{CC} = 1.1V ~ 5.5V		1	10	µA
ΔI _{CC}	1 つの入力は V _{CC} - 0.6V、その他の入力は V _{CC} または GND	3.0V ~ 5.5V			500	µA
C _I	V _I = V _{CC} または GND	3.3V			3.5	pF
C _O	V _O = V _{CC} または GND	3.3V				pF

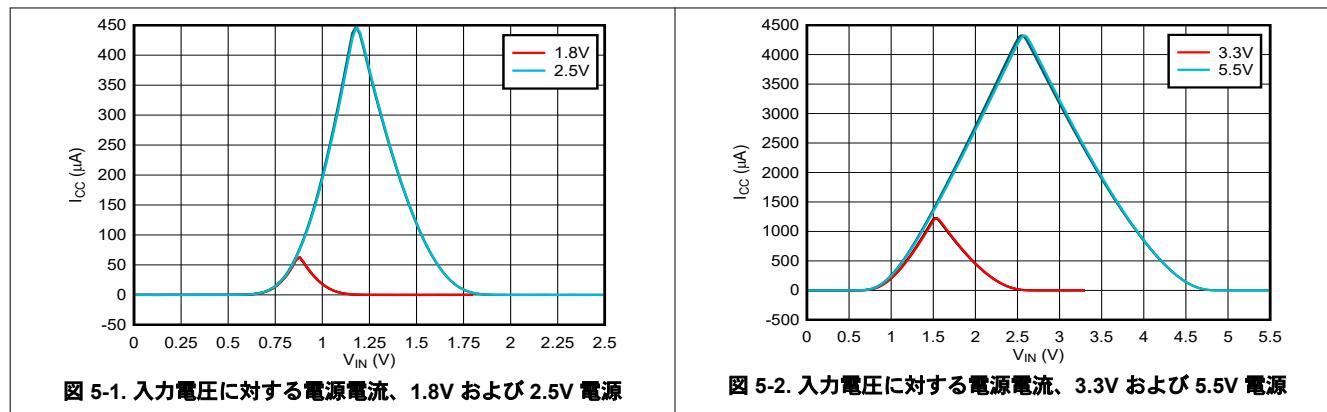
5.6 スイッチング特性

自由空気での動作温度範囲内、T_A = 25°C で測定した代表値 (特に記述のない限り)。「#i#パラメータ測定情報」を参照

パラメータ	始点 (入力)	終点 (出力)	負荷容量	V _{CC}	-55°C ~ 125°C			単位
					最小値	標準値	最大値	
t _{pd}	A または B	Y	C _L = 15pF	1.2V ± 0.1V		32.5	47	ns
t _{pd}	A または B	Y	C _L = 15pF	1.5V ± 0.12V		6	11	ns
t _{pd}	A または B	Y	C _L = 15pF	1.8V ± 0.15V		5.5	8	ns
t _{pd}	A または B	Y	C _L = 15pF	2.5V ± 0.2V		4	4.8	ns
t _{pd}	A または B	Y	C _L = 15pF	3.3V ± 0.3V		3	3.7	ns
t _{pd}	A または B	Y	C _L = 15pF	5.0V ± 0.5V		2	3.4	ns
t _{pd}	A または B	Y	C _L = 30pF	1.8V ± 0.15V		2.4	6	11
t _{pd}	A または B	Y	C _L = 30pF	2.5V ± 0.2V		1.1	4.3	7.5
t _{pd}	A または B	Y	C _L = 50pF	3.3V ± 0.3V		1	3.8	6.5
t _{pd}	A または B	Y	C _L = 50pF	5.0V ± 0.5V		1	2.9	5
C _{pd}			f = 10MHz	1.8V		21		pf
C _{pd}			f = 10MHz	2.5V		24		pf
C _{pd}			f = 10MHz	3.3V		26		pf
C _{pd}			f = 10MHz	5V		31		pf

5.7 代表的特性

$T_A = 25^\circ\text{C}$ (特に記述のない限り)



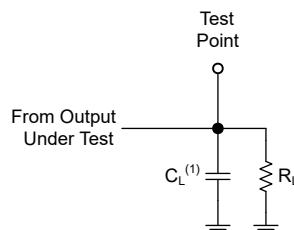
6 パラメータ測定情報

以下の表に示す例では、波形間の位相関係を任意に選択しました。すべての入力パルスは、以下の特性を持つジェネレータによって供給されます。PRR $\leq 1\text{MHz}$, $Z_O = 50\Omega$, $t_t \leq 2.5\text{ns}$ 。

出力は個別に測定され、測定するたびに入力が 1 回遷移します。

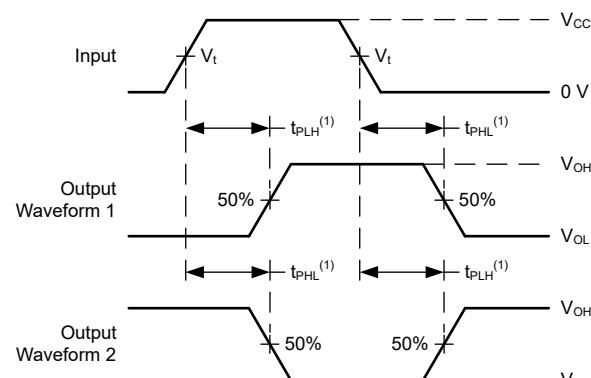
表 6-1. プッシュプル出力

V_{CC}	V_t	R_L	C_L	ΔV
$1.2V \pm 0.1V$	$V_{CC}/2$	$2\text{k}\Omega$	15pF	$0.1V$
$1.5V \pm 0.12V$	$V_{CC}/2$	$2\text{k}\Omega$	15pF	$0.1V$
$1.8V \pm 0.15V$	$V_{CC}/2$	$1\text{k}\Omega$	$15\text{pF}/30\text{pF}$	$0.15V$
$2.5V \pm 0.2V$	$V_{CC}/2$	500Ω	$15\text{pF}/30\text{pF}$	$0.15V$
$3.3V \pm 0.3V$	$1.5V$	500Ω	$15\text{pF}/50\text{pF}$	$0.3V$
$5.0V \pm 0.5V$	$1.5V$	500Ω	$15\text{pF}/50\text{pF}$	$0.3V$



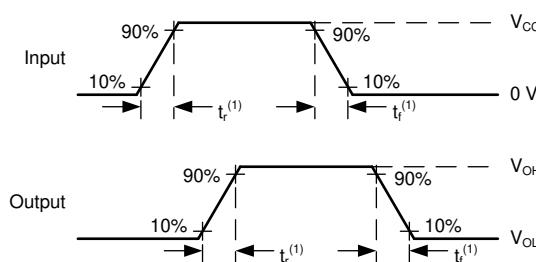
(1) C_L にはプローブとテスト装置の容量が含まれます。

図 6-1. プッシュプル出力のための負荷回路



(1) t_{PLH} と t_{PHL} の大きい方が t_{pd} に相当します。

図 6-2. 電圧波形、伝搬遅延



(1) t_r と t_f の大きい方が t_t に相当します。

図 6-3. 電圧波形、入力および出力の遷移時間

7 詳細説明

7.1 概要

SN54SC1G08-SEP デバイスはシングル 2 入力正論理 AND ゲートです。デバイスは、ブール関数 $Y = A \bullet B$ つまり、 $Y = \overline{A} + \overline{B}$ を正論理で実行します。

7.2 機能ブロック図



図 7-1. 論理図 (正論理)

7.3 機能説明

7.3.1 平衡化された CMOS プッシュプル出力

このデバイスには、平衡化された CMOS プッシュプル出力が内蔵されています。「平衡化」という用語は、デバイスが同様の電流をシンクおよびソースできることを示します。このデバイスの駆動能力により、軽負荷に高速エッジが生成される場合があるため、リングを防ぐために配線と負荷の条件を考慮する必要があります。さらに、このデバイスの出力は、デバイスを損傷することなく維持できる以上に大きな電流を駆動できます。過電流による損傷を防止するため、デバイスの出力電力を制限することが重要です。「[絶対最大定格](#)」で定義されている電気的および熱的制限を常に順守してください。

未使用のプッシュプル CMOS 出力は、未接続のままにしておく必要があります。

7.3.2 標準 CMOS 入力

このデバイスには、標準 CMOS 入力が搭載されています。標準 CMOS 入力は高インピーダンスであり、通常は電気的特性に示されている入力容量と並列の抵抗としてモデル化されます。ワースト ケースの抵抗は、「[絶対最大定格](#)」に示されている最大入力電圧と、「電気的特性」に示されている最大入力リーケ電流からオームの法則 ($R = V / I$) を使用して計算されます。

標準 CMOS 入力では、「推奨動作条件」表の入力遷移時間またはレートで定義されるように、有効なロジック状態間で入力信号を迅速に遷移させる必要があります。この仕様を満たさないと、消費電力が過剰になり、発振の原因となる可能性があります。詳細については、『[低速またはフローティング CMOS 入力の影響](#)』を参照してください。

動作中は、標準 CMOS 入力をフローティングのままにしないでください。未使用の入力は、 V_{CC} または GND に終端させる必要があります。システムが入力を常にアクティブに駆動している訳ではない場合、システムが入力をアクティブに駆動していないときに有効な入力電圧を与えるため、プルアップまたはプルダウン抵抗を追加できます。抵抗値は複数の要因で決まりますが、 $10\text{k}\Omega$ の抵抗を推奨します。通常はこれですべての要件を満たします。

7.3.3 クランプダイオード構造

図 7-2 は、このデバイスの入力と出力には負のクランプダイオードのみがあることを示しています。

注意

絶対最大定格表に規定されている値を超える電圧は、デバイスに損傷を与える可能性があります。入力と出力のクランプ電流の定格を順守しても、入力と出力の電圧定格を超えることがあります。

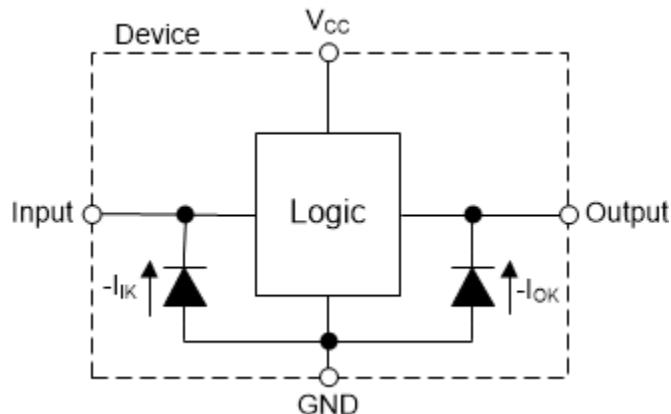


図 7-2. 各入力と出力に対するクランプダイオードの電気的配置

7.4 デバイスの機能モード

機能表 に、SN54SC1G08-SEP の機能モードを示します。

表 7-1. 機能表

入力 ⁽¹⁾		出力 ⁽²⁾
A	B	Y
H	H	H
L	X	L
X	L	L

(1) H = High 電圧レベル、L = Low 電圧レベル、X = ドントケア

(2) H = High に駆動、L = Low に駆動、Z = 高インピーダンス状態

8 アプリケーションと実装

注

以下のアプリケーション情報は、TI の製品仕様に含まれるものではなく、TI ではその正確性または完全性を保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

8.1 アプリケーション情報

AND ゲートの一般的なアプリケーションは、電源シーケンスに使用されます。電源シーケンスは、デバイスの誤動作を防ぐために、特定の電圧タイミング要件を持つプロセッサや他の繊細なデバイスを必要とするアプリケーションで頻繁に採用されます。SN54SC1G08-SEP を使用してプロセッサがオンになっていることを検証することにより、有害な信号からプロセッサを保護できます。

8.2 代表的なアプリケーション

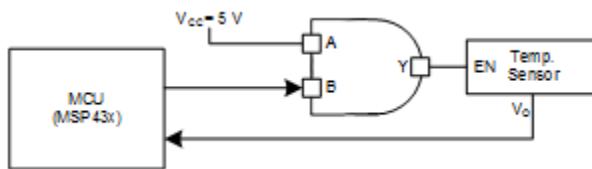


図 8-1. 電源シーケンス アプリケーション

8.3 設計要件

SN54SC1G08-SEP デバイスは CMOS 技術を使用し、平衡型出力ドライブを採用しています。上限値を超える電流が流れる可能性があるため、バスが競合しないように注意します。

SN54SC1G08-SEP により、デジタル制御信号を使用して、アナログ信号とデジタル信号のスイッチング制御が可能になります。最適な動作を行うには、すべての入力信号を 0V または V_{CC} のいずれかにできるだけ近い電位に維持してください。

8.3.1 電源に関する考慮事項

目的の電源電圧が「[推奨動作条件](#)」で規定されている範囲内であることを確認します。電気的特性セクションに記載されているとおり、電源電圧の設定により、本デバイスの電気的特性が決まります。

正電圧の電源は、SN54SC1G08-SEP のすべて電源出力の総電流、すなわち、電気的特性に記載された静的消費電流 I_{CC} の最大値とスイッチングに必要な任意の過渡電流の合計に等しい電流を供給できなければなりません。ロジック デバイスは、正の電源から供給される電流のみをソースできます。「[絶対最大定格](#)」に記載された V_{CC} 総電流の最大値を超えないようにしてください。

グランドは、SN54SC1G08-SEP のすべての出力によってシンクされる総電流、電気的特性に記載された消費電流 I_{CC} の最大値、スイッチングに必要な任意の過渡電流の合計に等しい電流をシンクできなければなりません。ロジック デバイスは、グランド接続にシンクできる電流のみをシンクできます。「[絶対最大定格](#)」に記載された GND 総電流の最大値を超えないようにしてください。

SN54SC1G08-SEP は、データシートの仕様をすべて満たしつつ、合計容量 50pF 以下の負荷を駆動できます。これより大きな容量性負荷を印加することができますが、50pF を超えることは推奨しません。

SN54SC1G08-SEP は、[電気的特性](#)表に定義されている出力電圧および電流 (V_{OH} および V_{OL}) で、 $R_L \geq V_O / I_O$ で記述される合計抵抗の負荷を駆動できます。High 状態で出力する場合、この式の出力電圧は、測定した出力電圧と V_{CC} ピンの電源電圧の差として定義されます。

総消費電力は、[CMOS の消費電力と Cpd の計算](#)アプリケーション ノートに記載された情報を使って計算できます。

温度の上昇は、[標準リニアおよびロジック \(SLL\) パッケージおよびデバイスの熱特性](#)アプリケーション ノートに記載された情報を使って計算できます。

注意

絶対最大定格に記載された最大接合部温度 ($T_{J(max)}$) は、本デバイスの損傷を防止するための追加の制限値です。「[絶対最大定格](#)」に記載されたすべての制限値を必ず満たすようにしてください。これらの制限値は、デバイスへの損傷を防ぐために規定されています。

8.3.2 入力に関する考慮事項

入力信号は、 $V_{IL(max)}$ を超えるとロジック Low と見なされ、 $V_{IH(min)}$ を超えるとロジック High と見なされます。絶対最大定格に記載されている最大入力電圧範囲を超えないようにしてください。

未使用の入力は、 V_{CC} またはグランドに終端させる必要があります。入力がまったく使われていない場合は、未使用の入力を直接終端させることができます。入力が常時ではなく、時々使用される場合は、プルアップ抵抗かプルダウン抵抗と接続することも可能です。デフォルト状態が High の場合にはプルアップ抵抗、デフォルト状態が Low の場合にはプルダウン抵抗を使用します。コントローラの駆動電流、SN54SC1G08-SEPへのリーク電流（「電気的特性」で規定）、および必要な入力遷移レートによって抵抗のサイズが制限されます。こうした要因により $10\text{k}\Omega$ の抵抗値がしばしば使用されます。

SN54SC1G08-SEP は CMOS 入力を備えているため、正しく動作するには、「推奨動作条件」表で定義されているように、入力が素早く遷移する必要があります。入力遷移が遅いと発振が発生し、消費電力の増大やデバイスの信頼性の低下を招くことがあります。

このデバイスの入力の詳細については、「機能説明」セクションを参照してください。

8.3.3 出力に関する考慮事項

正の電源電圧を使用して、出力 High 電圧を生成します。出力から電流を引き出すと、「電気的特性」の V_{OH} 仕様で規定されたように出力電圧が低下します。グランド電圧を使用して、出力 Low 電圧を生成します。出力に電流をシンクすると、「電気的特性」の V_{OL} 仕様で規定されたように出力電圧が上昇します。

非常に短い期間であっても、逆の状態になる可能性があるプッシュプル出力は、互いに直接接続しないでください。これは、過電流やデバイスへの損傷を引き起こす可能性があります。

同じ入力信号を持つ同一デバイス内の 2 つのチャネルを並列に接続することにより、出力駆動の強度を高めることができます。

未使用の出力はフローティングのままにできます。出力を V_{CC} またはグランドに直接接続しないようにしてください。

本デバイスの出力の詳細については、「機能説明」セクションを参照してください。

8.4 詳細な設計手順

1. 推奨入力条件:

- 立ち上がり時間と立ち下がり時間の仕様については、「推奨動作条件」表の $\Delta t/\Delta V$ を参照してください。
- 規定された High および Low レベルについては、「推奨動作条件」表の V_{IH} および V_{IL} を参照してください。
- 入力および出力は過電圧許容で、任意の有効な V_{CC} において最高 5.5V に対応できます。

2. 推奨出力条件:

- 負荷電流は $\pm 50\text{mA}$ を超えてはいけません。

3. 周波数選択の基準:

- 周波数がデバイスの消費電力に及ぼす影響は、『CMOS 消費電力と C_{pd} の計算』SCAA035 で調べる必要があります。
- トレース抵抗と容量を追加すると、最大周波数能力が低下する可能性があります。レイアウトのセクションに記載されているレイアウト手法に従ってください。

8.5 アプリケーション曲線

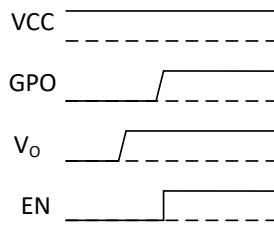


図 8-2. 代表的なアプリケーションのタイミング図

8.6 電源に関する推奨事項

電源には、「[推奨動作条件](#)」に記載された電源電圧定格の最小値と最大値の間の任意の電圧を使用できます。

電源の外乱を防止するため、各 V_{CC} 端子に適切なバイパスコンデンサを配置する必要があります。SN54SC1G08-SEPには、 $0.1\mu F$ バイパスコンデンサを推奨します。異なる周波数のノイズを除去するため、複数のバイパスコンデンサを並列に配置します。通常、 $0.1\mu F$ と $1\mu F$ の値のコンデンサを並列にして使用します。

8.7 レイアウト

8.7.1 レイアウトのガイドライン

- バイパスコンデンサの配置
 - デバイスの正電源端子の近くに配置
 - 電気的に短いグランド帰還パスを提供
 - インピーダンスを最小化するため、広いパターンを使用
 - 可能な場合はいつでも、ボードの同じ側にデバイス、コンデンサ、パターンを配置
- 信号トレースの形状
 - $8\text{mil} \sim 12\text{mil}$ のトレース幅
 - 伝送ラインの影響を最小化する 12cm 未満の長さ
 - 信号トレースの 90° のコーナーは避ける
 - 信号トレースの下に、途切れのないグランドプレーンを使用
 - 信号トレース周辺の領域をグランドでフラッドフィル
 - 平行配線は、3倍以上の誘電体厚で分離する必要があります
 - 12cm を超えるパターン用
 - インピーダンス制御トレースを使用
 - 出力の近くに直列ダンピング抵抗を使用して、ソース終端
 - 分岐を回避。個別に分岐が必要なバッファ信号

8.7.2 レイアウト例

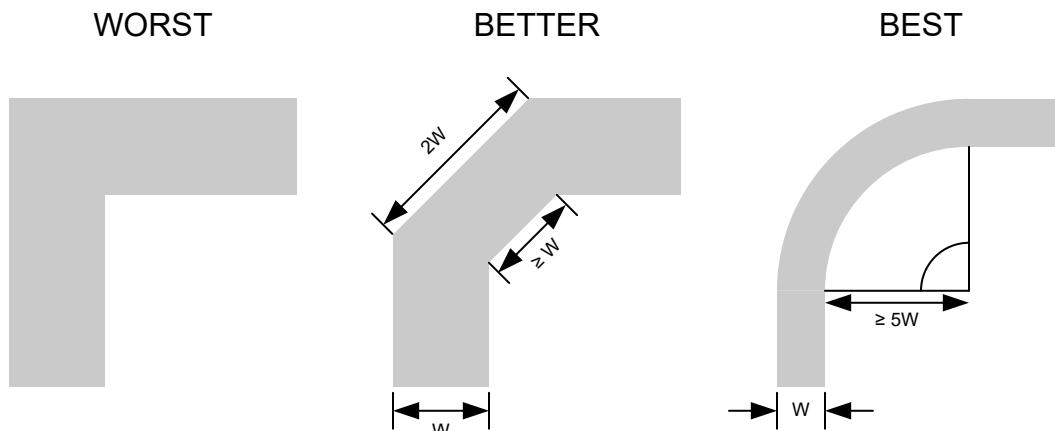


図 8-3. シグナルインテグリティ向上のためのサンプルパターンのコーナー

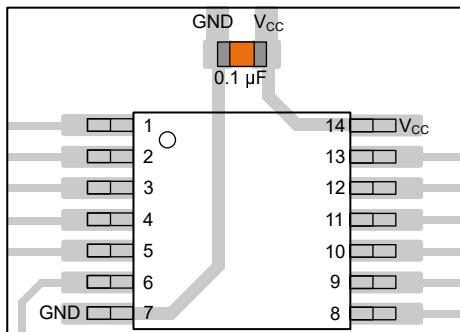


図 8-4. TSSOP や類似のパッケージに対応するバイパス コンデンサの配置例

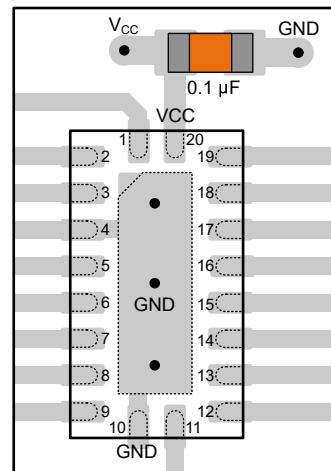


図 8-5. WQFN や類似のパッケージに対応するバイパス コンデンサの配置例

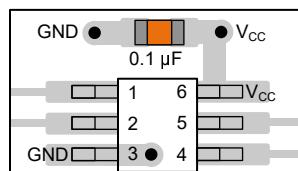


図 8-6. SOT、SC70、および類似のパッケージに対応するバイパス コンデンサの配置例

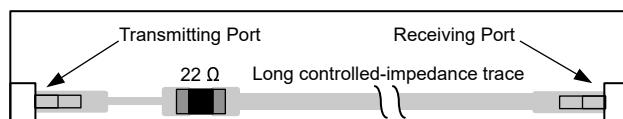


図 8-7. シグナル インテグリティ向上のためのダンピング抵抗の配置例

9 デバイスおよびドキュメントのサポート

テキサス・インスツルメンツは、幅広い開発ツールを提供しています。デバイスの性能の評価、コードの生成、ソリューションの開発を行うためのツールとソフトウェアを以下で紹介します。

9.1 ドキュメントのサポート

9.1.1 関連資料

関連資料については、以下を参照してください。

- テキサス・インスツルメンツ、『CMOS の消費電力と C_{pd} の計算』アプリケーションノート
- テキサス・インスツルメンツ、『ロジック設計』アプリケーションノート
- テキサス・インスツルメンツ、『標準リニアおよびロジック (SLL) パッケージおよびデバイスの熱特性』アプリケーションノート

9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、www.tij.co.jp のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

9.3 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計で必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの [使用条件](#) を参照してください。

9.4 商標

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

9.5 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

9.6 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#) この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

10 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

日付	改訂	注
July 2025	*	事前情報のリリース

11 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスに使用できる最新のデータです。このデータは、予告なく、このドキュメントを改訂せずに変更される場合があります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。

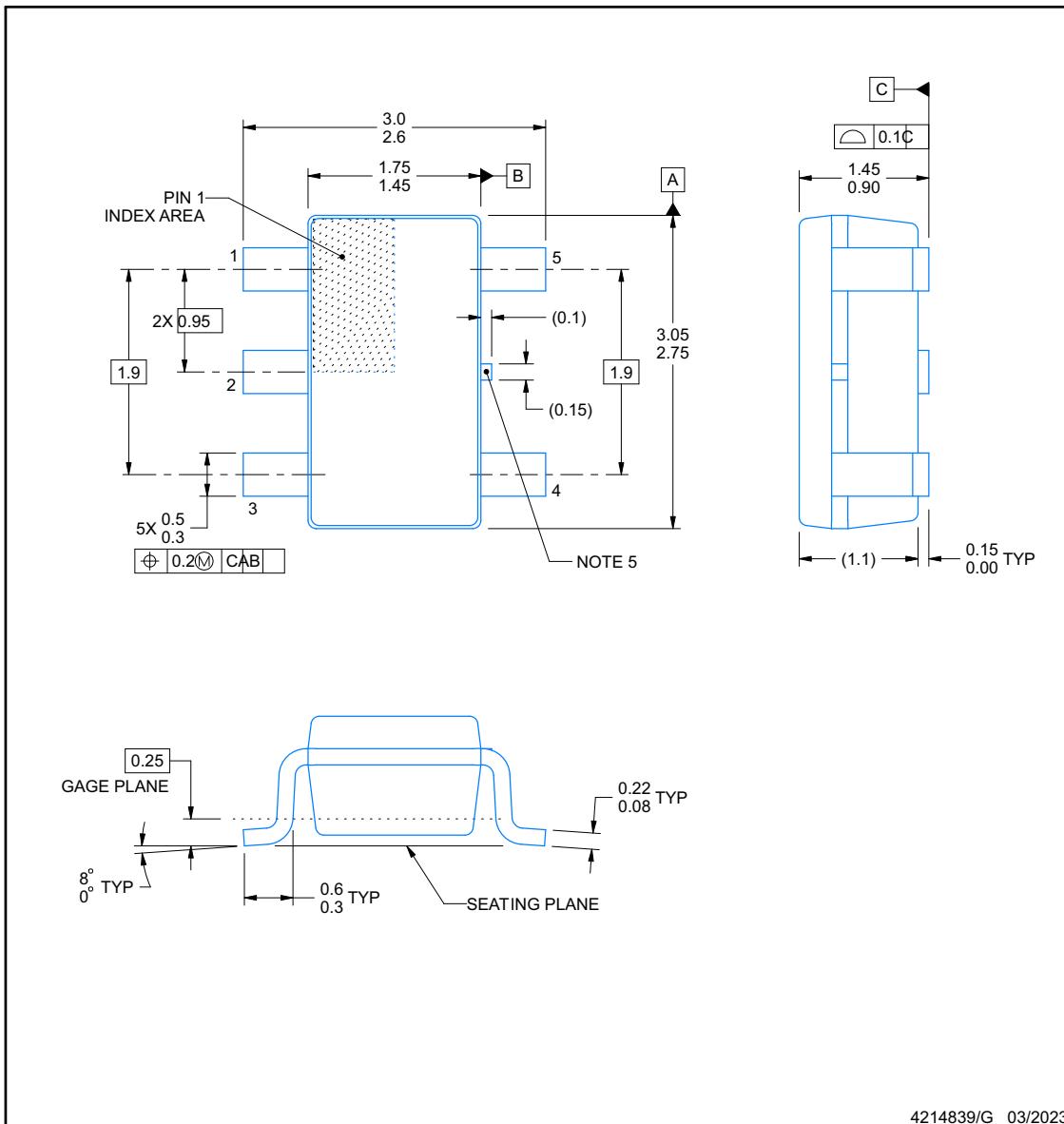
DBV0005A



PACKAGE OUTLINE

SOT-23 - 1.45 mm max height

SMALL OUTLINE TRANSISTOR



4214839/G 03/2023

NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
 2. This drawing is subject to change without notice.
 3. Reference JEDEC MO-178.
 4. Body dimensions do not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.25 mm per side.
 5. Support pin may differ or may not be present.

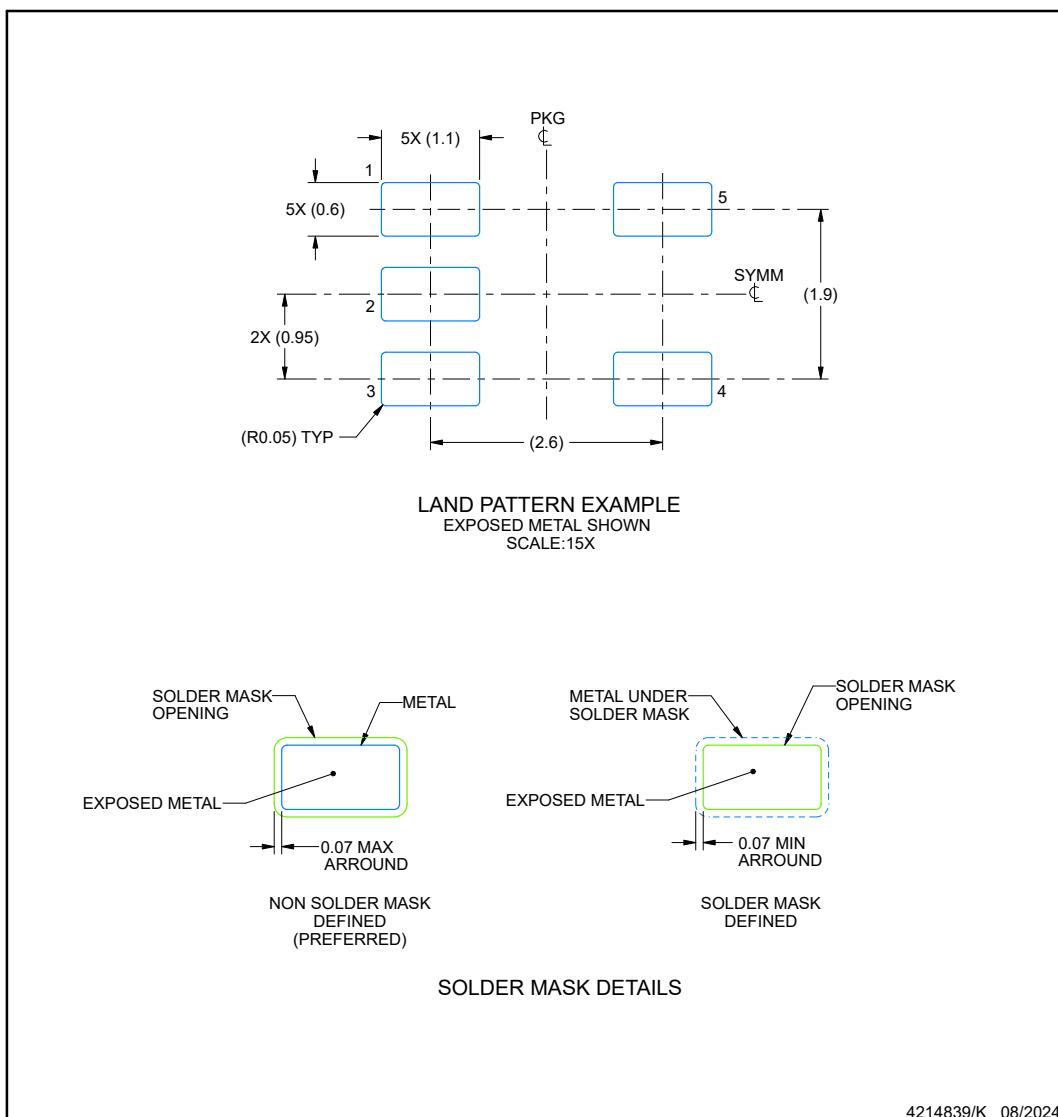


EXAMPLE BOARD LAYOUT

DBV0005A

SOT-23 - 1.45 mm max height

SMALL OUTLINE TRANSISTOR



NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ（データシートを含みます）、設計リソース（リファレンス デザインを含みます）、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の默示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または默示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した テキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている テキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または ti.com やかかる テキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいづれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用されるテキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265

Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
PN54SC1G08MDBVTSEP	Active	Preproduction	SOT-23 (DBV) 5	250 SMALL T&R	-	Call TI	Call TI	-	

⁽¹⁾ **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

⁽²⁾ **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

⁽³⁾ **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

⁽⁴⁾ **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

⁽⁵⁾ **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

⁽⁶⁾ **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

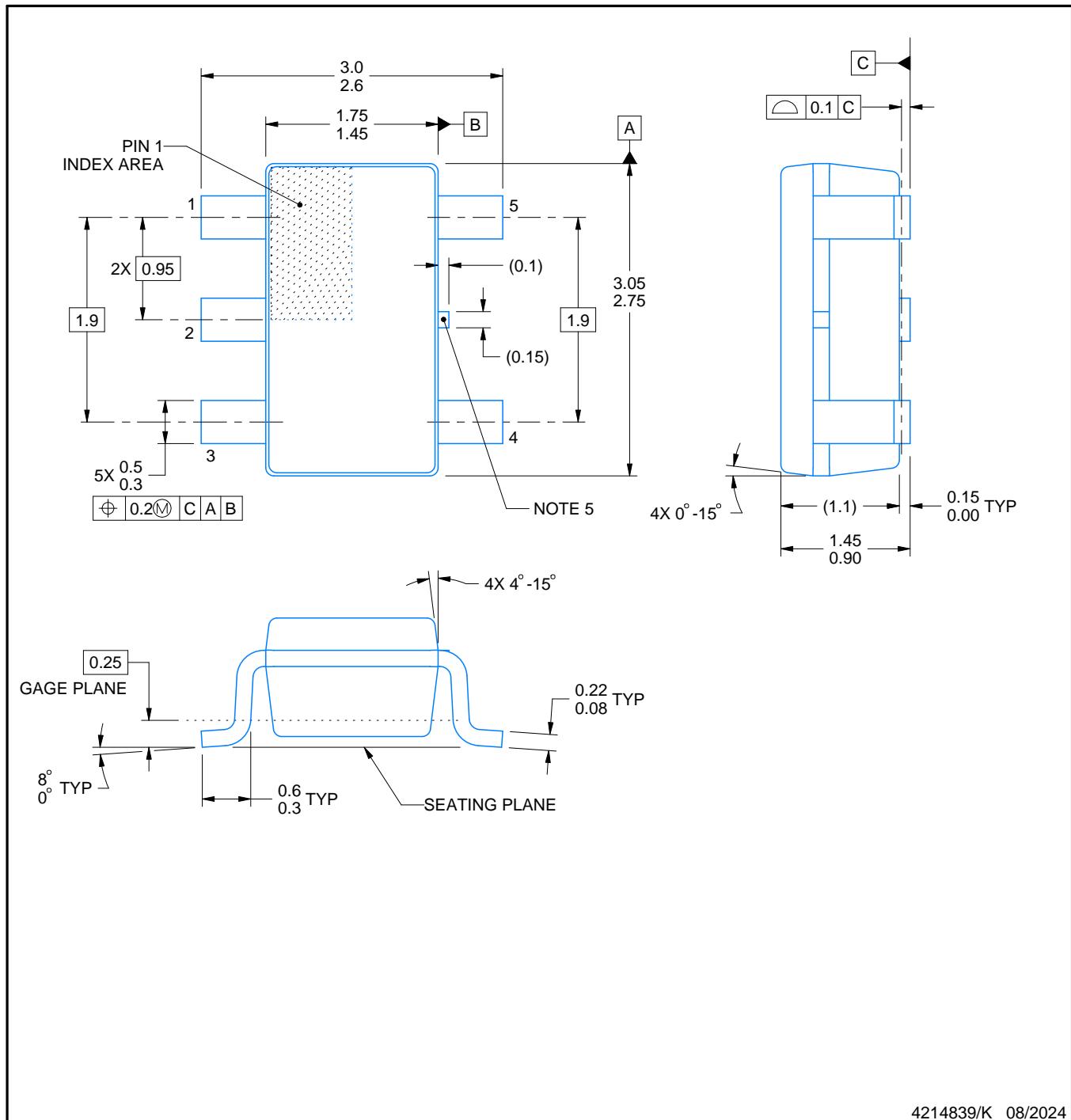
PACKAGE OUTLINE

DBV0005A



SOT-23 - 1.45 mm max height

SMALL OUTLINE TRANSISTOR



4214839/K 08/2024

NOTES:

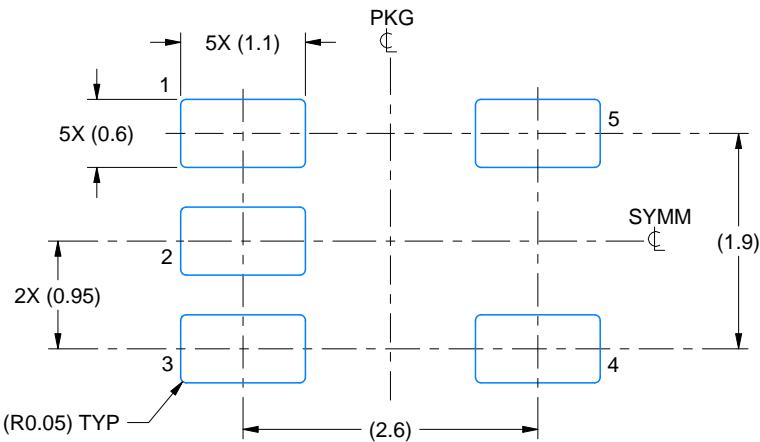
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
 2. This drawing is subject to change without notice.
 3. Reference JEDEC MO-178.
 4. Body dimensions do not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.25 mm per side.
 5. Support pin may differ or may not be present.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

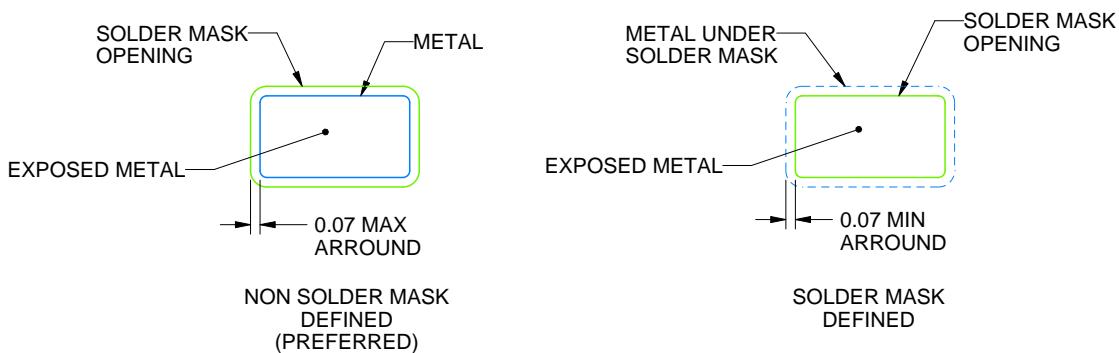
DBV0005A

SOT-23 - 1.45 mm max height

SMALL OUTLINE TRANSISTOR



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:15X



SOLDER MASK DETAILS

4214839/K 08/2024

NOTES: (continued)

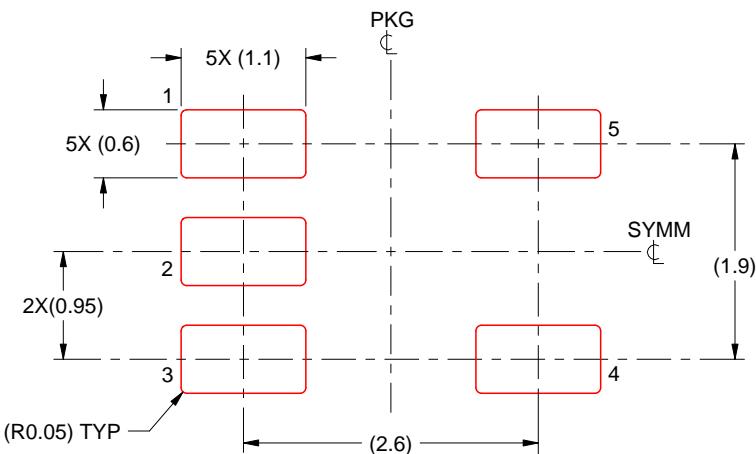
6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

DBV0005A

SOT-23 - 1.45 mm max height

SMALL OUTLINE TRANSISTOR



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE:15X

4214839/K 08/2024

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の默示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または默示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したもので、(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、[TI の総合的な品質ガイドライン](#)、[ti.com](#) または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated

最終更新日：2025 年 10 月